EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER : 11199864 PUBLICATION DATE : 27-07-99

APPLICATION DATE : 12-10-98 APPLICATION NUMBER : 10289891

APPLICANT: KOTO GIJUTSU KENKYUIN KENKYU

KUMIAI:

INVENTOR: SALTOKEN:

INT.CL. : C09K 11/06 H05B 33/10 H05B 33/14

H05B 33/22

TITLE : PRODUCTION OF

ELECTROLUMINESCENCE DEVICE

ABSTRACT : PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for producing an electroluminescence device improved in surface roughness and interfacial contact, and having high apparent density and thermal stability.

> SOLUTION: This electroluminescence device comprises a transparent substrate, a transparent electrode, a metallic electrode, and an organic intermediate layer situated between the above two electrodes which is composed of an organic luminescent layer, selective electron hole transport layer and selective electron transport layer, and contains an electronically active substance dispersed in a polyimide matrix of the formula (A is derived from a dianhydride; B is derived from a diamine; (n) is an integer of ≥2). The method for producing this device comprises a 1st process for providing the organic intermediate layer through the formation of a polyimide precursor layer containing the electronic active substance by vacuum vapor deposition of a dianhydride, diamine and the electronic active substance, and a 2nd process for the thermal imidation of the polyimide precursor layer.

COPYRIGHT: (C)1999,JPO

BNSDOOID <JP___411199664A_AJ_>

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公別番号

特選平11-199864

(43)公開日 平成11年(1999)7月27日

(51) Int.Cl. ⁶	Υ-	徽 河記号	FI				
C09K	11/06	6 5 0		11/06	6 11 0		
H05B	33/10	300			550		
11000	33/14			33/10			
				33/14	۸		
33/22			33/22		В		
					D)	
			審查請	求 有	請求項の数15	OL (全 20 頁	
(21) 出版番号		特膜平10-289891	(71) 出線人 59807/897				
				社団法	人高等技術研究院	研究組合	
(22) 山鳳日		平成10年(1998)10月12日			国、ソウル特別市	中区南大門路5世	
(21) (W. H. H.	e di se co			526番	_		
(31)優先権主張番号		1997-52097	(7%)発明者		≜ ぎょんぐ▼		
(32) 優先日		1997年10月10日		大韓民	国、京畿道463-0	50城南市盆唐区丰	
(33)優先権主張国		韓国 (KR)		AUG	ん▼洞308番地大	テアパート610棟	
(31)優先権主張裕号		1997-52099		203号			
(32)優先日		1997年10月10日	(72)発明者	金 湾	重		
(33)優先權主張国		韓国 (KR)		大路民	■ 関、釜山広域市61	7-019対トは超却	

(54) 【発明の名称】 電気発光素子の製造方法

(31) 優先権主張器号 1997-52337

(57)【要約】

(32)優先日

(33) 優先橋主導国

【課題】表面相度が改善され、見かけ密度および熱安定性が高く、界面接触が改善された電気発光素子を製造することを課題とする。

1997年10月13日

韓国 (KR)

【解決手段】透明基板、透明電極、金属電極、及び二つの電極の間に位置と有機発光層、接触的正相熱送層及 に放射的電子幅度とある。 下記化1のオリイミドマトリックスに分散された電子的活性物質を含有する有機 中間層を含む電気発光素子の製造方法において、有機中 間層を、二無水物、ジアミン及び電子的活性物質を含 を蒸着して電子的活性物質を含有するポリィミド前駆体 層を所載する第1の工程と、ポリイミド前駆体層を熱イ ミド化する第2の工程と、ポリイミド前駆体層を熱イ ミド化する第2の工程とと異備することを特徴とする電 気発光素子の製造方法。

【化1】

102村902号

(74)代理人 弁理士 鈴江 武彦 (51.4名)

2洞10-21番地パンドボラメマドタウン

最終頁に続く

但し、前記化1で、Aは二無水物から誘導され、Bはジアミンから誘導され、nは2以上の整数である。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 透明基板、適明電極、金属電極、および 前配二つの電極の間に位置し、有機発光層、選択的正孔 輸送層および選択的電子輸送層からなり、下記一般式で ある化10ポリイミドマトリックスに分散された電子的 活性物質を含むする有機中間層を含む電気発光素子の裂 遠方法において

前記有機中間層を、二無水物、ジアミンおよび電子的活 性物質の薬泉を薫落して電子的活性物質を含有するポリ イミド前駆体層を形成する際、の工程と、前記ポリイミ ド前駆体層を無くミド化する第2の工程とを具備することを特徴とする電気発光素子の製造方法。

[fb1]

但し、前記化1で、Aは二無水物から誘導され、Bはジ アミンから誘導され、nは2以上の整数である。

【請求項2】 前記第1の工程において、電子的活性物質、二無水物およびジアミンの蒸気を1:2:2 さいし2:1:1のモル比で0.01ないし0.02 nm s c cの素養速度の下で蒸着することを特徴とする請求項1に記載の電気発光素子の製造方法。

【請求項3】 前記第2の工程において、前記熱イミド 化を150ないし300℃の温度で1ないし10時間の 間行うことを特徴とする請求項1に記載の電気発光素子 の製造方法

【請求項4】 前記二無水物が、ビロメリト酸二無水 物、3、4、3'、4'-ビフェニルテトラカルボン酸 二無水物、3、3′、4、4′-ベンゾフェノンテトラ カルボン酸二無水物、4、4'-(ヘキサフルオロプロ ビリデン) ジ無水フタル酸、4、4'ー(ジメチルシリ コン) ジ無水フタル酸、4、4' - オキシジ無水フタル 酸、3、3、4、4、一ジフェニルスルホンテトラカ ルボン酸二無水物、1、1'-ビス(3、4-ジカルボ キシルフェニル二無水物) 1-フェニル-2,2,2 ートリフルオロエタン、9、9 ービス(トリフルオロ メチル)-2,3,6,7-クサンテンテトラカルボン 酸二無水物、テルフェニルテトラカルボン酸二無水物、 1.2.3.4-シクロベンタンテトラカルボン酸一無 水物、ナフタレン-1、4、5、8-テトラカルボン酸 二無水物、3、4、9、10-ベリレンテトラカルボン 酸二無水物、4-(2,5-ジオキソテトラヒドロフラ ン-3-イル)テトラリン-1, 2-ジカルボン酸無水 物、5-(2、5-ジオキソテトラヒドロフリル)-3 - メチル-3-シクロヘキセン-1,2-ジカルボン酸 無木物、ビシクロ [2, 2, 2] オウトーアーエンー 2, 3, 5, 6ーテトラカルボン酸二無木物。2, 2' -ジーセープチルビフェニル・ビス (無ホフタル酸エ ーテル)、2, 5'ージーセーブチルフェニルービス (無ホフタル酸エーテル)、ビスフェノール Aービス (無ホフタル酸エーテル)からなる群から選ばれること を特徴とする請求項1に記載の電気発光素子の製造方 法.

【請求項5】 前記ジアミンが 4.4' - オキシジフ ェニレンジアミン、ローフェニレンジアミン、4、4' ジアミノジフェニルメタン、3、4 ジアミノジフェ ニルメタン、4、4ージアミノジフェニルメタン、2、 2ービス(4ーアミノフェニル)プロバン、2、2ービ ス(4-アミノフェニル) ヘキサフルオロブロバン 1.1ービス(4ーアミノフェニル)-1-フェニルー 2.2.2ートリフルオロエタン、ベンジジン、2.2 ービス(トリフルオロメチル)ベンジジン、1、3ービ ス(3-アミノフェノキシル)ベンゼン、3,5-ジア ミノトルエン、3、4 ージアミノジフェニルエーテル: 4.4'-フェニレンジアミン.3.4-フェニレンジ アミン、3、3-ジアミノジフェニルエーテル、3、 ヨンアミノジフェニルメタン、2、5ージメチルー p-フェニレンジアミン、2、3、5、6-テトラメチ ル p-フェニレンジアミン、ジアミノフルオレン、ジ アミノフルオレノン、4、4'-ジアミノベンゾフェノ ン、4、4'ージアミノビフェニル、4、4'ージアミ ノビベンジル、3、3、-ジアミノベンゾフェノン、 4, 4' -ジアミノスルフィド、α, α' -ビス(4-アミノフェニル)-1,4-ジイソプロピルベンゼン。 2. 2-ビス「4-(4-アミノフェノキシ)フェニ ル]プロパン、1、4-ビス(4-アミノフェノキシ) ベンゼン、2,2-ビス[4-(3-アミノフェノキ シ)フェニル]ヘキサフルオロプロバン、2、2ービス [4-(4-アミノフェノキシ)フェニル] ヘキサフル オロプロバン、1、4-ビス(4-アミノフェノキシ) ベンゼン、2、6-ジアミノトルエン、メシチレンジア ミン、4、4' ジアミノジフェニルスルホン、3、 3'ージアミノジフェニルスルホン、3,3'ービス (アミノフェニル) ヘキサフルオロブロバン、2、2-ビス(3 アミノー4-ヒドロキシフェニル) ヘキサフ ルオロプロパン、4、4'ービス(2-2ロロアニリ ノ)メタン、4、4ービス (アミノシクロヘキシル) メタン、2、2'-ビス(3-アミノ-4-メチルフェ ニル) ヘキサフルオロプロパン 3.4'-ジアミノベ ンゾフェノン、4,4'ージアミノビベンジル、4. 4' ービス (アミノフェニル) ヘキサフルオロプロバ ン、1、3'ービス(mーアミノフェノキシ)ベンゼ ン、4、4'ーメチレンービスーのートルイジン、3、 3' ージアミノー4、4' ージヒドロキシビフェニル 4.4 -ジアミノオクタフルオロジフェニル 4.

4'-ビス(アミノフェニル)セレン化物、9,10-ピス(3-アミノフェニルチオ)アントラセン、9,1 0ービス(4-アミノフェニルチオ)アントラセン、 9、10-ビス(3-アミノアニリノ)アントラセン。 9、10-ビス(4-アミノアニリノ)アントラセン、 アクリジンイエローG、アクリフラビン、3,6-ジア ミノアクリジン、6、9ージアミノー2ーエトキシアク リジン、塩基性フクシン、メチル化塩基性フクシン、 2, 4-ジアミノー6-フェニルー1, 3, 5-トリア ジン、9,10-ジアミノフェナントレン、3,8-ジ アミノー6-フェニルフェナントリジン、臭化ジミジウ ム、臭化エチジウム、ヨウ化プロビジウム、チオニン、 3, 7ージアミノー5ーフェニルフェナジウムクロリ ド、3、3' ージメチルナフチジンからなる群から選ば れることを特徴とする請求項1に記載の電気発光素子の 製造方法。

【請取項6】 前記電子的活性物質が、4 - (ジシアノ メチレン) - 2 - X + λ D - C - X + λ D - C - X + λ D - - X + λ D - - X + λ + λ

リス(4, 4, 4ートリフルオロー1 - (2ーチエニル) - 1, 3ープタンジオノ) - 1, 10 - フェナント ロリンユウロビウム(III)、トリス(2, 4ーペンタジオノ) - 1, 10 - フェナントにリンテルビウム(III)、トリス(4, 4, 4 - トリフルオロー1 - (2ーチエニル) - 1, 3ープタンジオノ) - 1, 10 - フェナントロリンジスプロシウム(III) およびこれらの混合物からなる群から遊ばれる有機発光物質であることを特徴とする論求項1に記載の電気発光素子の顕遠方法

$$\begin{array}{c|c} & & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & \\ & & \\ &$$

【化31

[化4]

但し、前配化4で、R、R¹ 、R² およびR³ は各々独立的にアルキルまたは芳香族置換体であり、mは1以上の整数である

【請求項8】 前記有機発光層の厚さが、20ないし3 0nmの範囲であり、正孔輸送層の厚さが16ないし4 0nm範囲であることを特徴とする請求項1に記載の電 気条光素子の製造方法

【請求項9】 耐記金属電極上に二無水物とジアミンを 真空状態で業着重合してポリイミド商節外膜を形成し、 耐記ポリイミド削略体膜を熱イミド化してポリイミド保 観膜を形成して業子を密閉する段階をさらに合む請求項 1に記載の電気発光素子の製造方法。

【請求項10】 1)第1二無水物と第1シアミンを真空 ※着報合して第1ボリイミド前駅体層を形成し、2)第1 ポリイミド層を熟イミド化して第1ボリイミド層を形成 し、3)第2二無水物と第2ジアミンを真空蒸着塩合して 第2ボリイミド前駆体層を形成し、3)前記第2ボリイミ ド門原体層を無くミド化する段階を続返して、第1ボリイミ ドの音が変われた構造の分布されたフラッグ反 射機を前辺透明基板と透明性低との間に形成する段階を きらに含むことを特徴とする請求項1に記載の気格で気発光 素子の製造方法。

【請求項11】 前記正孔輸送層のポリイミドマトリックスが、1、10 e V ないし1、90 e V の電子観和度を有する二無水物とジアミンから形成されることを特徴とする請求項1に記載り電気発光業子の製造方法。

【請求項12】 前記電子輸送層のボリイミドマトリックスが、6.80ないし7.70eVのイオン化ポテンシャルを有するジアミン化合物と二無水物から形成されることを特徴とする請求項1に配数の電気発光素子の製造方法

【請求項15】 南北正孔輸送層が、正孔伝達物質、二無水物およびジアミンの漂気を1:2:2をいし2: 1:1の中止比で0.01でいし0.02m sec の薬若連改のトで真空素者単合させて形成されることを 特徴とする請求項1に記載の電気発光票子の製造方法。 【請求項11】 前記有候形光層が、有機光光物質、二 無水物およびジアミンの蒸気を1:2:2ないし2: 1:1のそれ上で0.01をいし0.02m sec の蒸着連度のトで真空蒸着乗合させて形成されることを 特徴とする請求項1に記載の電気発光素子の製造方法。 【請求項15] 前記を「接続層所、電子機造物質、二 信義享項15] 前記を「接続層所、電子機造物質、二

日本本物及びシアミンの素気を1:2:2ないし2:1: 1のモル比で0.01ないしの.02mm.secの素 着速度の下で真空蒸着重合させて形成されることを特徴 とする請求項1に記載の電気発光素子の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】木発明は、電気発光素子の製造方法に関する。さらに詳細には、真空素着法を用いて 熱安定性が改善され、表面が均一な高密度のポリイミド 審膜を含有する電気発光素子を製造する方法に関する。 【0002】

【従来の技術】一般に、電気飛光素子は、適明電極、金 環電極、および南託二つの電極の間に位置する有機発光 原を含む有機関からなる保障部と有し炎症とは直流 で駆動される 直流駆動の場合は、透明電極が四極、危 電電極が陰極に作用する。電気飛光効率を高めるため に、有機関は近日雑活層および電子輸送層を多層構造の 形でさらに含み得る。

【0003】例えば、直流駆動の場合、別念の正孔輸送 無が網施と有機発光層の間に研ざされて位置し得る。また、選択的空電子輸送層を接極層と有機発光度の間に押 入し得る。能ので、用いられる有機物質によって電気発 大素子の有機層は単層、2層または3層であり得るもの の層は種々の潮合せの有機形光物質。正孔能送物質およ が電子に達物管などの電子的活性物質を含有する。 陽極 としては、インジウム・スズ酸化物・ガラス層が正しい いられ、酸極としてはマグネシウム、アルミニウム、イ ンジのよまたは鏡・マグネシウムの連属層が用いられ る 【0004】しかし、電子的活性物質を通常の真空蒸著 法に従って製造した有機層、例えば正孔維減層は、業子 を駆動する際に発生する振動、結晶化および拡散移動な どによって変形または破壊され易く、業子の寿命が短い という問題があった。

【0005】このような問題を解決するため、有機落構を用いるスピンコートのような選式工程を通じて活性物質が高分子でトリックスに分散された有機容を製造する方法が提示された。しかし、このような方法で製造された有機用は表面阻度が高く、低い見かけ密度、有機物質による汚染などの問題を有する。また、この方法になって多慮の有機中間層を形成する場合、層面の接着力が十分でないため、界面接触が強くなり、素子の寿命が短いという問題があり、さらに、層厚さが比較的厚いため素子のターンオン(turn on)電圧が高くなる。

【0006】従って、表面相度が改善され、見かけ密度 および熱安定性が高く、界面接触が改善された電気発光 素子の製造方法の開発が要求される。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】本発明はこうした事情 を考慮してなされたもので、表面租度が改善され、見か け密度および無安定性が高く、界面接触が改善された電 気発光素子の製造方法を提供することを目的とする。 【0008】

【課題を解決さるための手段】本発明は、連明基板、通明基板、通明電極、無隔電機、および前記二つの電極の間に位置 し、有機発売。選供的正形地間はおよび提供的電子輸 透層からなり、下記一板式である化5のボリイミドマト リックス(polyimide matrix)に分散 された電子的活性物質を含有する有機中間層を含む電気 発光素子の製造方法において、前記有機中間層を含む電気 発光素子の製造方法において、前記有機中間層を含む電気 を対して、対して、前記有機中間層を含む電気 を対して、前記有機中間層を発生を形成する を対して、前記有機中間層を発生を形成する を前りの工程と、前記ボリイミド前駆休層を無く手化 (thermal imidization)する第2 の工程と表現術することを特徴とする電気発光素子の製 達方法である。

【0009】 【化5】

但し、前記化5で、Aは二無水物から誘導され、Bはジアミンから誘導され、nは2以上の整数である 【0010】

【発明の実施の形態】以下、本発明をさらに詳細に説明

する。

【0011】本発明の一般様による電気発光素子は、ガ カスのような透明基板上にコーティングされたインジウ ムスズ酸代物(indium tin oxide:以 下、ITOという)層を予め決定されたパターンに従っ ご適常の方法でエッチングして競遣した場種と、アルミ ニウム、マグネシウム、カルシウム、銀またはその他金 属または合金で製造した金属電極層と、前記透明電極層 まはな金属電極の間に締ぎして位置する有能光層を 含む有機中間層とからなる。本発明の電気発光素子は突 流または直流をあった中部され得る。直流性時の場合、 透明性極い解析となり、金属で成は接触として作用す 定期性極い解析となり、金属で成は接触として作用す

【0012】前記有機中間層は透明電極層および有機発 光層の間に挟まれた正孔輸送層をさらに含み得る。また、有機中間層は金属電極層および有機光層の間に挿 入された電子輸送層をさらに含み得る。

【0013】税って、有機中間関は、有機発光物質、正 加輸送物質および電子輸送物質をどのような組合せで用 いるかによって単層または多層精造の形態で製造し得 る。例えば、有機中間層は、正孔輸送 有機発光層およ で電子輸送網、また住正孔輸送層および有機発化。電子 輸送層からなる二層形態であり得る。また、有機中間層 は正孔輸送層、有機発光層および電子輸送層からなる三 原形館であり得る。

【0014】本発明の実施において、一つ以上の有機中間階に前記化5のポリイミドが用いられる。本発明に使用され待る阿示的なポリイミドは、下記化6に示す一般 成の二無水物および下配化7に示す一般式のジアミンを真空素者匿名して得ることができる。

[0015]

【化6】

[化7]

ここで、AおよびBは前記定義した通りである

【0016】化6の三無水物の例としては、ピロメリト 酸二無水物、3,4、3'、4'-ビフェニルテトラカ ルボン酸二無水物、3、3'、4、4'ーベンゾフェノ ンテトラカルボン酸二無水物、4,4'-(ヘキサフル オロプロビリデン) ジ無水フタル酸、4、4'~(ジメ チルシリコン) ジ無水フタル酸、4、4'-オキシジ無 水フタル酸、3、3'、4、4' ジフェニルスルホン テトラカルボン酸 二無水物 1,1' - ビス(3,4 -ジカルボキシルフェニル二無水物)-1-フェニルー 2, 2, 2-トリフルオロエタン, 9, 9'ービス(ト リフルオロメチル)-2,3,6,7-クサンテンテト ラカルボン酸二無水物、テルフェニルテトラカルボン酸 二無水物。1、2、3、4 ーシクロペンタンテトラカル ボン酸二無水物、ナフタレン-1、4、5、8-テトラ カルボン酸二無水物、3、4、9、10-ペリレンテト ラカルボン酸二無水物、4-(2,5-ジオキソテトラ ヒドロフラン-3-イル)テトラリン-1、2-ジカル ボン酸無水物、5-(2,5-ジオキソテトラヒドロフ リル) -3-メチル-3-シクロヘキセン-1, 2-ジ カルボン酸無水物、ビシクロ[2、2,2]オクト-7 -エン-2,3,5,6-テトラカルボン酸二無水物、 2.2'ージーセーブチルビフェニルービス(無水フタ ル酸エーテル)、2、5' ジ t・ブチルフェニル ビス (無水フタル酸エーテル)、ビスフェノールA ビ ス(無水フタル酸エーテル)などが挙げられる。前記二 無水物から誘導された前記化5のポリイミドのAの構造 は、下記の化8に示す通りである。

【0017】 【化8】

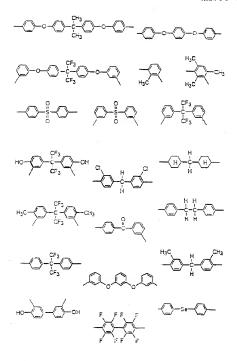
前記化7のジアミンの例としては、4、4'ーオキシジ フェニレンジアミン、ローフェニレンジアミン 4. 4'-ジアミノジフェニルメタン、3、4-ジアミノジ フェニルメタン、4、4ージアミノジフェニルメタン、 2, 2-ビス(4-アミノフェニル)プロバン、2, 2 - ビス (4-アミノフェニル) ヘキサフルオロプロパ ν , 1, 1- \forall 2, (4-r \geq 2) τ =1, 1- τ =2 ルー2、2、2ートリフルオロエタン、ベンジジン、 2,2-ビス(トリフルオロメチル)ベンジジン、1、 3-ビス(3-アミノフェノキシル)ベンゼン、3、5 ージアミノトルエン、3、4ージアミノジフェニルエー テル、4、4' ーフェニレンジアミン、3、4ーフェニ レンジアミン、3、3-ジアミノジフェニルエーテル: 3, 3' ージアミノジフェニルメタン、2, 5ージメチ ルーローフェニレンジアミン、2、3、5、6ーテトラ メチルーロ・フェニレンジアミン、ジアミノフルオレ ン、ジアミノフルオレノン、4、4'ージアミノベンゾ フェノン、4,4'-ジアミノビフェニル、4,4'-ジアミノビベンジル、3、3'-ジアミノベンゾフェノ

ン、4, 4' ージアミノスルフィド、 α , α' ービス (4- T ミ / フェニル) - 1 . 4 - ジ イソプロピルベンゼン、2、2-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フ ェニル] プロバン、1、4-ビス(4-アミノフェノキ シ)ベンゼン、2、2ービス[4-(3-アミノフェノ キシ)フェニル] ヘキサフルオロプロパン、2,2-ビ ス [4 - (4 - アミノフェノキシ) フェニル] ヘキサフ ルオロプロバン、1、4-ビス(4-アミノフェノキ シ) ベンゼン、2、6ージアミノトルエン、メシチレン ジアミン、4、4' -ジアミノジフェニルスルホン、 3,3'-ジアミノジフェニルスルホン、3,3'-ビ ス(アミノフェニル) ヘキサフルオロプロバン、2、2 ビス(3-アミノー4-ヒドロキシフェニル)へキサ フルオロブロバン、4、4'-ビス(2-クロロアニリ ノ)メタン、4、4ービス (アミノシクロヘキシル) メタン、2, 2'ービス(3-アミノ-4-メチルフェ ニル) ヘキサフルオロブロバン、3、4' ージアミノベ ンゾフェノン、4、4'ージアミノビベンジル、4、 4'-ビス(アミノフェニル)へキサフルオロプロパ

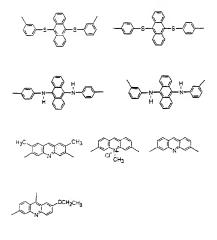
ン、1、3'・ビス(m-アミノフェノキシ)ペンゼ ン、4、4'・メチレン・ビスーのトルイジン、3 "・ジアミノー4、4'・ジドドロキシビフェニル、 4、4'・ジアミノオクタフルオロジフェニル、4、4 4'・ビス(5 アミノフェニルトサ)アントラセン、9、1 ロービス(1 エアミノフェニルチオ)アントラセン、9、1 ロービス(3 アミノアコリ)アントラセン、9、1 の、10 ビス(3 アミノアコリ)アントラセン、7 アクリジンイエローG、アクリフラビン、3、6・ジア ミノアクリジン、ムロービス・2 ジン、塩量仕ァクシン、メールに塩基性フシン、メールに塩基性フシン、メーリジンをは、1 リジン、塩量仕ァクシン、メールに塩基性フタシン、メールに塩基性フタシン、メールに 2、4ージアミノー6ーフェニルー1、3、5ートリア ジン、9、10ージアミノフェナントレン、3、8ージ アミノー6ーフェニルフェナントリジン、奥化ジミジウム、奥化エチジウム、日ウ化プロビジウム、キオニン、 3、7 ジアミノー5 フェニルマェナジウムクロリ ド、3、3 ージメチルナフチジンなどがある。前記ジ アミンから誘嘴された前記化5に示すホリイミドのBの 構造は、下配化9、化10、化11、化12に示す通り である。 [0018]

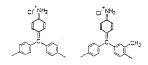
H₃C CH₃

【化10】



【化11】





【化12】

本発明においては、二無水物とジアミンを活性物質とともに基材または他の有機関上に真空蒸着してボリアミク 酸 (poly/な価。 acid))のようなポリイミド 部隊体を形成し、前記ポリイミド 前部体を熱処理して活性物質がポ ガイミドに分散された前部のホリイミド 履老形成することによって 森健中間間を製造 中間 を とによって 本後中間間で製造 といる。例として、二無木物 として PMD Aを用い、ジアミンとして OD Aを用いる 反応を下記化13の(1) ~ (4) に示す。 【 OO 19】

【化13】

(1)
$$\begin{array}{c} \begin{array}{c} & & & \\ & & \\ & & \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} & \\ & \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} & \\ & \\ & \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} & \\ & \\ & \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} & \\ & \\ & \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} & \\ & \\ & \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} & \\ & \\ & \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} & \\ & \\ & \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} & \\ & \\ & \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} & \\ & \\ & \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} & \\ & \\ & \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} & \\ & \\ & \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} & \\ & \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} & \\ & \\ & \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} & \\ & \\ \end{array} \\ \\ \begin{array}{c} & \\ & \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} & \\ \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} & \\ \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} & \\ \\ \end{array} \\ \begin{array}{$$

化13において、PMDAの二無木物残茎とODAのアミノ残茎とが反応してカルボン酸中間体を経てポリアミノ般が形成し、次いで、熱処理によってポリアミク酸がポリイミドに転換する。このような変善重合法によって

生成されたボリイミドフィルムは通常の湿式方法による ものより高い密度を有する。

【0020】電子的活性物質は正孔輸送物質、有碳発光 物質、電子輸送物質およびこれるの混合物からなる群か ら選ばれる。本発明に用いられる活性物質は二無水物お よびジアミンと反応しない。

【0021】本発明の真空素着重合段階においては、活性物質、二無水物およびジアミンの蒸気を1:2:2ないし2:1:1のモル比で0.01ないし0.02nmsecの素着速度で素着することが好ましい。

【〇〇22】本発明において、正孔輸送層は、通常の正 孔輸送物質で単独で蒸着するか、通常の違式工程によっ で製造され得るが、好ましくは、正礼輸送物質、二無水 物およびジアミンを真空蒸着してポリイミド前駆体層を 形成し、前記ポリイミドに分散されたボリイミド海酸を形 成立として正孔輸送物 質が化ちのボリイミドに分散されたボリイミド海酸を形 成することによって製造され

【0023] 具体的な正孔検法物質の例としては、下記 化14の一般式(IV)のN、N'ージフェニルーN、 N'ービス(3ーメチルフェニル)ー1、1'ージフェ ニルー4、4'ージアミン、下記化14の一般式(V)の ジアミン、下記化14の一般式(VII)のエトラゾーン、下記化14の一般式(VIII)のに、一下PD、下記化14の一般式 (VIII)のC、一下PD、下記化14の一般式 (VIII)のTD・TPD、下記化14の一般式 (X)のTD・TPD、下記化15の一般式(X)の4、4'、4"ートリス(3ーメチルフェニルーフェニルア ミノ)トリフェニルアミン、下記化15の一般式(XI)及び下記化15の一般式(XII)の化合物を挙げることが でき、この3ち下PDが好ましい。 【0024】

【化14】

【化15】

耐記化15で、R. R¹、R¹ 及びR² は余く独立的に である。特に、正孔緒送郷のボリイミドでトリックスを 電子観和度1、10ない1、190e Vの二無水物を用 いて製造する場合には、発光効率が大きく増加し得る。 代表的次二無水物の電子視和度を下記表1に示す。正孔 輸送層の厚さは16ない140nmである。 【0025】 (31)

二無水物	電子銀和旗 (eV)	ジアミン	イオン化ポテンシャル (aV)	
PMDA	1. 10	ODA	7, 22	
BTDA	1. 55	PDA	6. 88	
BPDA	1.38	BPDAM	6. 80	
TPDA	1.35	3FDAM	6.92	
6FDA	1. 30	ベンジジン	7 01	
3FDA	1. 30	APB	6. 85	
OPDA	1.30			

本発明において、有機党光間は、通常の有機発光物質を 単独で無着するか、通常の選択工程によって製造され得 あが、存ましたは、有機発光物質、二無水物およびジア ミンを真空悪着してポリイミド前郎体層を形成し、前記 ポリイミド前駅体を熱処理して有機発光物質が前記化5 のポリイミドに分散されたポリイミド薄膜を形成することによって影強される

[00026] 具体的な有機形光物質としては、トリス (8 - ヒドロキシキノリノラト) アルミニウム(AIg $_a$)、4 - (ジシアノメチレン) $_{-}$ $_{-$ ン、ビス(8ーキノリノラト)亜鉛(II)、9、10 ージフェニルアントラセン、トリス(4、4、4ートリ フルオロ・1 - (2ーチエニル) 1、3 - ブタンジオ ノ) - 1、10ーフェナントロリンユウロビウム(II 1) (Eu (TTFA) 3Phen)、トリス(2、4 ーベンタジオノ) - 1、10ーフェナントロリンテルビ ウム(III) (Tb (ACAC) 3Phen) および トリス(4、4、4ートリフルオロー1 - (2ーチエニ ル) - 1、3 - ブタンジオノ) - 1、10ーフェナント ロリンズスプロシウム(III) (Dy (TTFA) 3 Phen) などが解析をAAS

【0027】前記有機発光物質は、陽極上に又は正孔輸 送層が用いられる場合には正孔輸送層の表面上に形成さ れる。前記有機発光層の原さは、20ないし30nmの 独団である。有機発光層の厚さを調節することによって 本発列の業子のターンオン(turn-on)電圧を調 節することができる。

【0028】本発明において、電子輸送層は、通常の電子輸送物質を単独で業者するか、通常の湿式工程によって製造され得が、好ましたは、電子輸送物質、三無水物およびジアミンを真空農者してポリイミド前郎体層を形成し、前記ポリイミド高駅体を熱処理して電子輸送物質が前記化5のポリイミドに分散されたホリイミド清膜を形成することによって影響をよる。

【〇〇29】電子輸送物質の具体的な例としては、2-(4-ビフェニル) ーラー (4-ヒertーブチルフェ ニル) ー1、3、4-オキサシアゾール (フチルーPB D) 及びオキサジアゾール誘導係 (〇ND) が挙げられ る。電子輸送配良は、有機先光の製造助と 財政を手順に 従って有機発光層上に電子輸送物質を蒸着するか、ポリ イミドマトリックス中に分散された電子輸送物質層をコ ーティング に製造し得る

【0030】特に、電子輸送層のポリイミドマトリック スをイオン化ポテンシャル6、80ないし7、70eV のジアミンを用いて製造する場合には、発光効率が大き く増加し得る いくつのジアミンのイオン化ポテンシャ ル値を、前記表1に示す

【0031】図1は、本発明の一整様による電気発光素 子製造装置の映画図である。図中の付着1、2、3、4、 4、各々ロードロックキャンパー、子債洗浄ナャンパー、 一、正乳検送問形成チャンパー、有機発光層形成チャンパー、陸級電船ローティングチャンパーと示す。前配ロードロックチャンパーは、ダグネチックパー6と、基材を導入するためのクイックアウセスドアフと、サンブル 装着器 (基板ホルゲー)8と、ボンビングボート9と 支装着している。

【0032】前記正孔軸送階形成テナンバー2は、イオ ン供給額10と、サンプル装容器(基数ホルダー)11と、 ボンビングボート12とを装着している。前部A積軽光形 成チャンバー3は、サンプル装容器(基板ホルダー)13 と、マスフロー開節器14a、15a、16aを夫々介装した 配管14、15、10と、その電17、18、19と、ボンビングボート20とを装着している 前記るのば17、18、19には、 大々に無水物、ジアミン、正孔給送物質の物末が入って いる。

【0033】前記右機免光形成チャンバー3は、拡散セル21と、サンプル装着器(基板ホルダー)22と、ボンビングボート32を装着している。南記陸極電電コーティングチャンバー4は、電子ビーム業着器4と、サンプル業着器(基板ホルダー)35と、ボンビングボート26とを装着2でいる。

【0034】前記ロードロックチャンパー1、子備洗浄 チャンパー2、正孔伝達層形成チャンパー3、有機発光 層形成チャンバー4、陰極電極コーティングチャンバー 5は、ゲートパルプ27、28、29、30により相互に連結さ れている。

【0035】本発用の電気発光素子製造方法の一種様は、図1に示した装置を使って次のように行う。まず、 ボンビングボート9、12、20、32、36を通じ全体気空 システムを高真空状態に維持する ガラス - I T O 基板 をクイックアクセスドアウを通じてロードロックチェン ゲー1の基板ボルダー8に装着する。ボンビングボート 多通じてロードロックチェンバー1を高東をで維持し た後、ゲートバルブ27を開けてマグネチックバー6を用 いて I T O ガラ ス基板を干備流浄チャンバー2 の基板ホ ルゲー11に移す。

【0036】次に、マグネチックバー6を元の位置に移 し、ゲートパルブごを関めた後、イオン供給源16を用い て予備洗浄工程を行う。この際、イオン供給源16として は、Ar、O₂、N。交どが用いられる

【0037】予備洗浄チャンパー2での工程が終った 後、ゲートバルブ沼、20を開けてマグネチックパー6を 用いて基板を正孔伝達層形成チャンパー3の基板ホルダー13に移した後、マグネチックパー6を元に場所に移 し、バルブを閉める

10038]正孔離送層形成チャンバー3では、ボリイ ドド正孔・輸送物質(例えば、TPD)が分散された薄 膜を1下0支候に形成するために、1下0支候に二無水 物・ジアミン、そして正凡輸送物質の物未が入っている るつは17、18、19に熱を加えることによって特定真空下 を物質の素が発生するととになる。るつほを特定 度(例えば、二無水物:160~200で、ジアミン: 140~180で、正孔伝送物質:180~300で) に保持した後、マスワー・調節器14a、15a、16aを削 節して各物質の蒸気を特定の比率で反応物質を基板に蒸 着してホリアミク散薄膜を形成し、これた無処理して正 孔伝達物質を含むポリィミに環路を得る。

[0039]次に、拡散セル3が装着された有機発光層 形成チャンパー4に基板を移した後、0.03nm (0.3オンダストローム:0.3A sec以下の蒸 着速度で正孔輸送層上に有機発光物質を蒸着する。次い で、ゲートパルブ30を開け、基板をマグネチックパー6 を用いて基板ポルダーのに移り電子ビーム蒸発器34を用 いて物学の屋を索着して発光器子の除極を作る。

【0040】ポリイミドの真空蒸着重合の際に各物質の 組成比を正確に調節するために、残留気体分析器(RG A)及び厚さ測定器(表1に示されていない)を用いて ィードバックプロセスを適用してマスフローバルブを 正確に調節する。

【0041】前述の木発明の装置は、有機中間層の構造 によって任意に変更され得る。例えば、ボリイミドマト リックスを含む有機発光層を製造する場合、有機発光層 形成チャンパー4に一無水物及びジアミン用のるつぼを 各々設置し得る。

【0042】本発明の有機発光素子製造装置は、工程が 簡単であり、有機層の有機溶媒による汚染を避けること ができ、層厚さを精密に制御することができる

【0043】本発明においては、前述したように、有帳 発光物質、正孔輪送物質及び、又は電子輸送物質を含む 本発明の古機関は、単一層又は多層形態であり得る。例 えば、ポリエーテルイミド、有機発光物質及び正孔輸送 物質の配合物を陽極上にコーティングレて正孔輸送 複発光層を製造することによって、正孔輸送物質及び直 機発光層を製造することによって、正孔輸送物質及び有機発光物質とののの表表

【0044】また、有機発光及び電子輸送能力を共に有 する有機金属化合物。例えば、トリス(8-ヒドロキシ キノリノラト)アルミニウム(41-Q2)シを有機発光層 の製造物と類似な手順に従ってポリイミドマトリックス に分散して有機発光。電子輸送地一層を形成し得る。

【0045】さらに、有機発光素子の駆動の際に正孔な 基階から正孔が円滑に有機発光層に注入されるように正 孔輸送層に一定量の有機発光物質を混合し得る。また、 本発明の電気発光素子に電子輸送層が用いられる場合電 子輸送層にも有機発光物質を加えて接触性を改善し得 る。

【0046】図2は、本発明の一態様によって製造され

た電気発光率子の概略的な構造を示す。図2において、 付書引は透明基板を示す。この透明基板で1上には、透明 電極32、ポリイミド界面接合層33。正孔軸基層34、有機 発光層35。電子輸送層36、ポリイミド界面接合層37及び 金尾電極38が超気形成されている。前記透明電極32。金 属電極38が超気形成されている。 で高または市道であり得る。 なお、電力は で高または市道であり得る。

【0047】本発明の実施において、発光の特定放長を 増幅するために透明基材と1TO薄膜の間に、分布され たプラッグ反射機として限が率の異なる各種のボリイミ ドフィルムの税用をさらに導入することによって、発光 効率を増進させることができる。

【0048】本発用のか心されたブラック反射機は、 配 抗率が大きいポリイミドフィルムと小さい堀折率を有す るポリイミドフィルムを変互に積層して影波されたもの であり、特定の二無水物とジアミンからポリイミド前駆 体層を真定業育集らた後、これを熱処埋する過程を適 切に機返して製造され得る

【0049】代表的な二無水物とジアミンから製造されるボリイミドの屈折率を、下記表2に示す。 【0050】

【表2】

ポリイミド: 二年水物+ジアミン	誘電定数	風行率
PMDA+ODA	3. 22	1. 80
BTDA+4, 4'-ODA	3. 15	1.78
HTDA+3, 3'-ODA	3. 09	1. 76
ODPA+4, 4'-ODA	3. 07	1.75
ODPA+3, 3'-ODA	2. 99	1.73
6FDA+4, 4' ODA	2, 79	1. 67
6FDA+3, 3'-ODA	2. 73	1.65
6FDA+6FUAM	2, 39	1. 54

分布されたブラッグ反射機の反射率は、次の数1によって計算される(A. Dodabalapur et al., J. Applied Phys., 80 (12), P6953 (1996)参照)

[0051]

【数1】

$$R = \left[\frac{\left(\frac{n}{n}\right)^{2N} - 1}{\left(\frac{n}{n}\right)^{2N} - 1} \right]^{2}$$

前記数1で、n'は虚折率が高いポリイミド層の屈折 率、n"は屈折率が低いポリイミド層の屈折率、Nはポ リイミド層の組合せの数を示す。

【0052】例えば、照折率が1.80であるPMDA +ODAと屈折率が1.54である6FDA+6FDA 粉を各々誘電膜1と誘電膜1Iとして用いて交替に10 回蒸着して115nm厚さの10層の誘電膜対からなる

分布されたブラッグ反射機 (Distributed Bragg R effector: DBR)を形成し、有機発光物質としてTB を用いる場合。上記数1によって計算された反射率は 84となる。このように製造された高分子誘電順は 高反射率鏡 (High Reflective Mirror)として 作用し、反対側である陰極金属電極の完全鏡(Perfect Mirror)とともに平面微細空洞構造を形成して発光 の特定波長を増幅させ、妻子の発光効率を増加させる。 【0053】本発明の好ましい態様は次の通りである 前記正孔輸送層が、正孔伝達物質、二無水物およびジア ミンの蒸気を1:2:2ないし2:1:1のモル比で 0. 01ないLO. 02 nm secの業着速度の下で 真空蒸着重合して製造されることを特徴とする本発明に よる電気発光素子の製造方法。前記有機発光層が、有機 発光物質、二無水物およびジアミンの蒸気を1:2:2 ないし2:1:1のモル比で0,01ないし0,02n m. secの蒸着速度の下で真空蒸着重合して製造され

ることを特徴とする本発明による電気発光業子の製造方法。本発明では、接触抵抗を減らすと同時に金属と有機 層との接着を改善するだめに、陽極上に、または陰極を コーティングする前にポリイミド界面接合層をコーティ ングし得る

【0054】また、本発明の素子をカプセルで包み得 る一般に、電気発光素子はパラフィンなどを用いた溶 融工程を用いて製造完了した素子をパッケージングする 方法: ボリアミク酸を溶媒に溶かしてパッケージングす る溶媒工程があり; UV -硬化性重合体を用いてカプセ ルで包んだ後、紫外線に露光させる方法などを用いてパ ッケージングされ得る。しかし、溶融工程の場合、有機 物質が熱に敏感であるため、熱による発光素子の熱劣化 を避けることができなく、溶媒工程の場合、溶媒が発光 物質層に浸透して発光素子の劣化を誘発する。また、U V - 硬化性重合体を用いる場合、有機物質の大部分が紫 外線に弱いため発光素子の劣化が起こる。このような問 題を解決するために、本発明の有機発光素子を二無水物 およびジアミンを用いて真空蒸着重合によってポリイミ ドのカプセルに封入して空気および水分から保護するこ とによってその安定性を増加させ得る。

【0055】単一層および多層構造の有機+間間を有す 本発明の電気光差率において、ポリネミは素子の 安定性、電気飛光効率および奔動を増加するために一つ 以上の有機解に使用され得る。特に、有機+問題がボリ 大きド ホリモドの三層構のが懸さるみ合くには素 テの物型的反応性が非常に改善される。また、ボリイミ ドに分散される有機発光物板の量および印加電圧を調節 して発光の減失を調整し料る。

【0056】本発明の有機電気発光素子は平面的なディ スプレイ パネルの形に設造することが可能である。ま た、すべての有機圏に一つ比上のポリイミド閉が用いら れ、柔軟な電転が用いられる場合。柔軟な要示素子の製 造も可能である。さらに、本発明は、有機電気発光素子 だけでなく、太陽電池(solar cell)、FET (fiel d effect trasister)、光タイオードなどに活用され得 る。

[0057]

【実施例】以下、本発明を下記実施例によってさらに詳細に説明する。但し、下記実施例は本発明を例示するの みであり、本発明の範囲を創限しない。

【0058】 (実験例1)ます。透明基板としての適明 ガラス上に、ITOをコーティングして適即製版 (透明 電像)を製造した。つづいて、コーティングされた基板 をエキストラン (Fatrant)溶液・アセトン溶液・エタノ ルで各々1 時間超音液液力とた後、エタノールに保管 した、次に、洗消された基板をチャンバー内の試料装着 器に装着し、三つのるつぼに各々DCM、PMDAおよ びODAを約0、05×ボラカれた。

次に、チャンバー内の真空度を1.0/10%トール

(torr)にした後、各々のあつぼを加熱しはじめ た。この際、PMDAは180℃、ODAは160℃、 DCMは220ないし230℃に加熱した。石英電振器 を用いた厚さモニター(STM 100 MF)で各々 の蔗発速度が0.01ないし0.02nm secに一 定であるが確認した

【0059】次に、PMOA、ODAおよびDCMの蒸発速度が6、01ないし0、02nm secに安定化され、るつほの温度変化が±1で以下となったとき、試料装着機関のシャッターを開けて素着を始め、総厚さが30ないし32nmとなるまで業者を結けた。

【0060】次に、有機発光層が蒸落された1TOガラス基板を直接オーブンで1か当り2でずつ170でまで 不基板を直接オーブンで1か当り2でずつ170でまで 原温して170で40分階級地理した。つかに、熱 料理者は7が分え基板をさらに金属素着チェンバーの計 料装者器に移送して2×10ペトールの圧力の下ででか 料装者器に移送して2×10ペトールの圧力の下ででか 「0061】図3は、DCM PMDA-ODA開のU v可視光線吸収スペクトルを示す特性図である(但し、 (a):熱処理前、(b):熱処理能)、図3において、曲線(a),(b)は、それぞれ478、3 nm て、曲線(a),(b)は、それぞれ478、3 nm に、曲線(a),(b)は、それぞれ478、3 nm に、曲線(a),(b)に、55をV)の 入加 a x 値を有する。このような入加 a x の発は熱処理 による密度の増加に伴って、DC M分下間の密能が少な くなることに任限する。

【0062】(実施例2)まず、透明ガラス上にITO シコーティングとで透明機を製造した。つづいて、コーティングされた基版をエキストラン溶液・アセトン溶液・アセトン溶液・アセールに保管した。次に、洗金された基版をナキンバー内の試料装等部に装着し、三つのるつぼに各々TPD、DCM及びFMDAを約0.05まずつ入れた。チャンバー内内裏変度を1.0×10・トール(して・ア)にした後、各々のるつばを加熱しはじめた。この際、PMD Aは180℃、ODAは160℃、TPDは220℃に加熱した。石炭発展器を用いた厚さモニター(STM 100 MF)で各々の無円速期はた。

【0063】PMDA、ODAおよびDCMの薬発速度が0.01ないし0.02mm secに変定化され、 るつぼの温度変化が±1で以下となったとき、試料装着 器側のシャッターを開けて兼着を始め、絵厚さが30ないし32mmとなるまで業者を続けた。

【0064】この有機が示案された1下のガラス基板 を真空オーブンで1分当り2でずつ200でまで昇起 て200でで1時間熱処理した。次に、上型の熱処理さ れた基板をさらに有機発光層素着チェンバーの試料装着 器に移起し、AI q. を30 nmの厚さに蒸着し、さら に、アルミニウムを厚さ350 nmとなるように蒸着し た、野港されて素子のターンオン電圧は、下記表3に示 す通りである。 【0065】

【表3】

	PMUA: ODA: TPD	HTL (A)	ELL (A)	熱処理	ターンオン 電圧
実施例2	2:2:1	347	300	0	8.7
実施例3	1:1:1	347	300	0	8. 6
秀施例4	1:1:2	347	300	0	10. 4
突施例5	2:2:1	250	300	0	6. 6
美庭例6	1:1:1	250 .	200	0	5. 8
突縮例7	1:1:2	250	200	0	5. 7
突起例8	2:2:1	250	300	0	8. 17
実施例9	1:1:1	250	300	0	7. 05
实施例10	1:1:2	250	300	0	6. 54
比較例1	2:2:1	525	330	х	8. 9
比較例2	1:1:1	525	300	×	10. 2
比較例3	1:1:2	525	300	x	11.5
比較例4	2:2:1	450	200	x	7.66
比較例5	1:1:1	450	200	×	5.64
比較例6	1:1:2	450	200	×	6. 28

(実施例3~10)製造条件を上記表3に示すように変 化させることを除いては、実験例2の手順を繰り返し た、製造された業子のターンオン電圧は、上記表3に示 す、実施例でで製造した業子は、12 1m Wという 高い発光効率を示した。

【0066】(比較例1~6) 製造条件を上記表3に示 すように変化させることを除いては、実施例2の手順を 載り返した。製造された素子のターンオン電圧は、上記 表3に示す通りである。 (実施例11)

集施例 1 で製造した業子をサンフルホルダーに装着し、無水物とジアミンを蒸着(温度: PMDA: 185で、〇DA: 155で)して業子をカアセルで包んだ。【0067】(実施例12)まず、透明ガラス上にITのをコーティングして透明陽をを製造した。つづいて、基板を試料装容器に装着し、こつのるつ間に各・40PDA、〇DAはおび下PDを約0.01gずつブル、2210でトールの圧力、PMDAは180で、○DAは160で、TPDは220での条件の下で陽極上にポリアミクト観音を形成し、このホリアミクト観音を形成し、このボリアミクトを開発を180でで1時間熱処理して180mm厚空の正孔輸送層を形成し、

た。ひきつづき、Alq。を20nmの厚さに素着した 後、アルミニウムを厚さ350nmとなるように漂着し た。製造された楽子のターンオン電圧は5Vであり、9 Vでの発光効率は13 lm Wであった 【0068】(実施例13)正孔輸送層の厚さを15nmとすることを除いては、実施例12の手順を繰り返した。製造された素子のターンオン電圧は4Vであり、8 Vでの発光効率は13 lm Wであった

[0069]

【発明の効果】以上詳述したように、本発明によって製造された電気飛光素子は高い飛光効率を有する。また、 充発明によるポリイミド層は衝皮が高く、厚さがゆーで ある。したがって、本発明の方法によって製造された有 機層は有機電気発光素子の外にも有機半導体素子である 太陽電池 FET素子、有機環膜センサーなどに応用で きる。

【図面の簡単な説明】

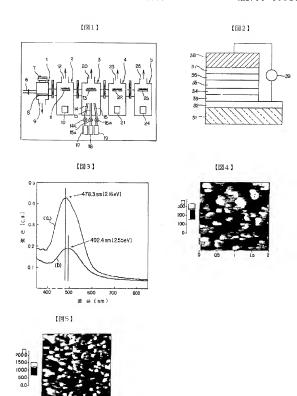
【図1】本発明の一態様による電気発光素子製造装置の 概略的な構造を示す。

【図2】本発明の一態様によって製造された電気発光素 子の概略的な構造を示す。

【図3】DCM PMDA-ODA層のUV可視光線吸収スペクトルの特性図を示す。

【図4】1 TO層表面のAtomic Force microscopyスペクトル写真を示す。

【図5】本発明の実施例2で製造した正孔伝達層表面の Atomic Force microscopyスペクトル写真を示す。



フロントページの続き

(31)優先権主張番号 1998-7040 (32)優先日 1998年3月4日 (33)優先権主張国 韓国(KR)

(31) 優先権主張番号 1998-23644

(32)優先日 1998年6月23日 (33)優先権主張国 韓国(KR) (31)優先権主張番号 1998-38469

(32) 優先日 1998年9月17日 (33) 優先権主張国 韓国(KR)

(72) 発明者 崔 東権

大韓民国、ソウル特別市138-240松坡区新

川洞ジャンミアパート2棟801号